

产品介绍

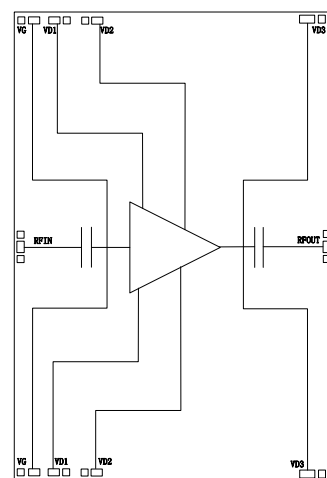
YGPA143-0812A1(X)是一款性能优良的 GaN 功率放大器芯片，频率范围覆盖 8~12GHz，可在脉冲和连续波模式下工作。脉冲模式下，小信号增益 36dB，饱和输出功率 48dBm，功率附加效率 45%；连续波模式下，小信号增益 34dB，饱和输出功率 47dBm，功率附加效率 45%。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结工艺。

关键技术指标

- 频率范围：8-12GHz
- 小信号增益（Pulse）：36dB
- 饱和输出功率（Pulse）：48dBm
- 功率附加效率（Pulse）：45%
- 功率增益（Pulse）：26dB
- 输入回波损耗（Pulse）：20dB
- 静态工作电流（Pulse）：1.85A@+28V
- 芯片尺寸：4.00mm × 5.75mm × 0.075mm

功能框图



电性能表（ $T_A=+25^{\circ}\text{C}$ ， $VD1=VD2=VD3=+28\text{V}$ ， $VG=-2.65\text{V}$ ，Pulse 模式）

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	8	—	12	GHz
小信号增益	Gain	—	36	—	dB
饱和输出功率	Psat	—	48	48.5	dBm
功率附加效率	PAE	—	45	53	%
功率增益	Gp	—	26	—	dB
输入回波损耗	RL_IN	—	20	—	dB
动态电流	IDD	—	5	—	A
静态工作电流*	IDQ	—	1.85	—	A

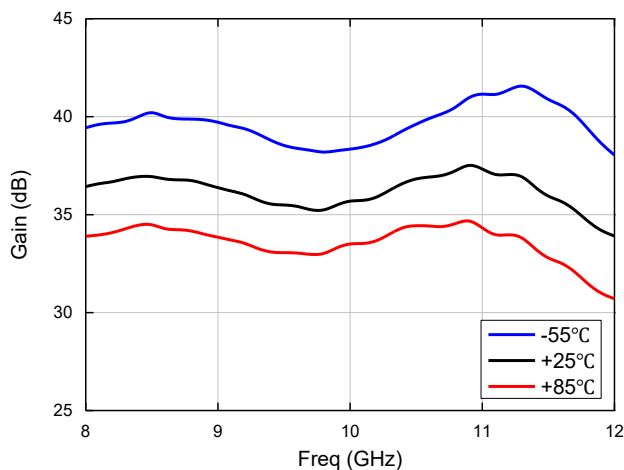
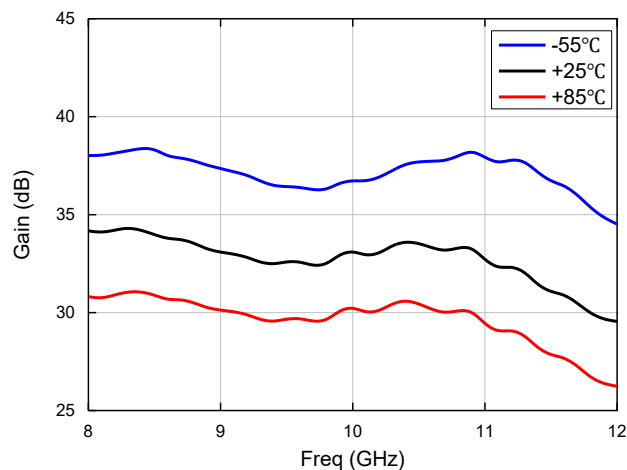
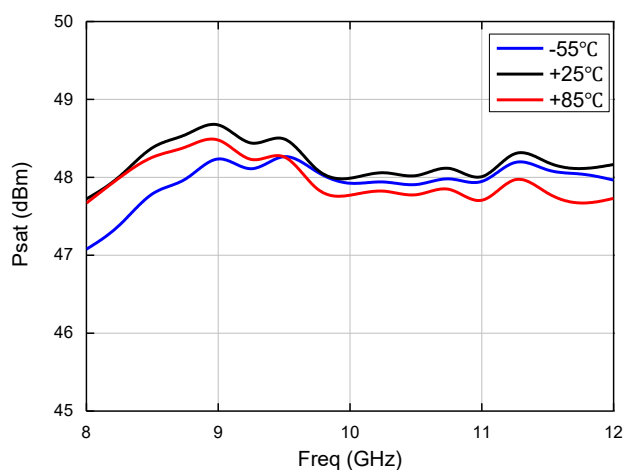
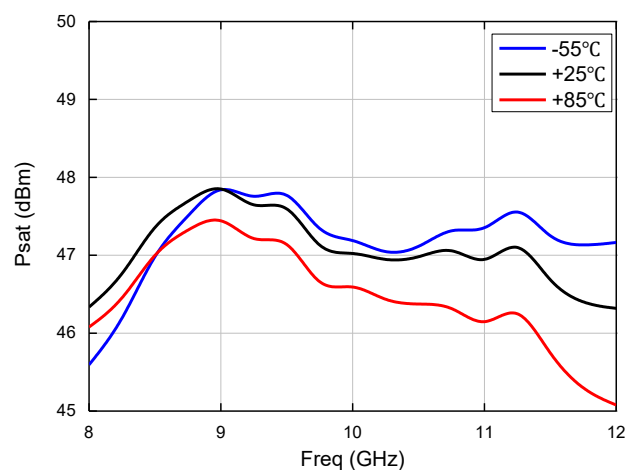
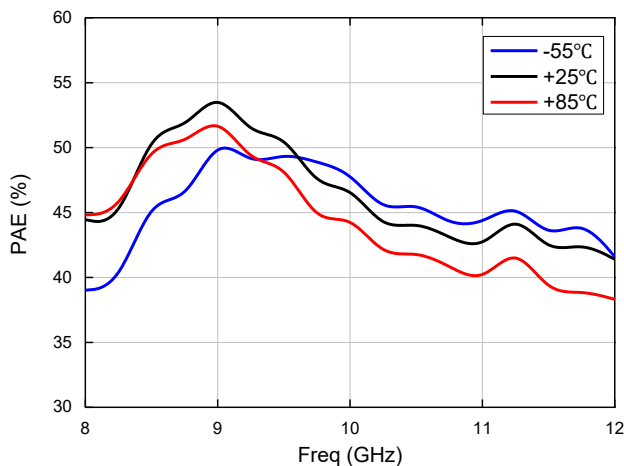
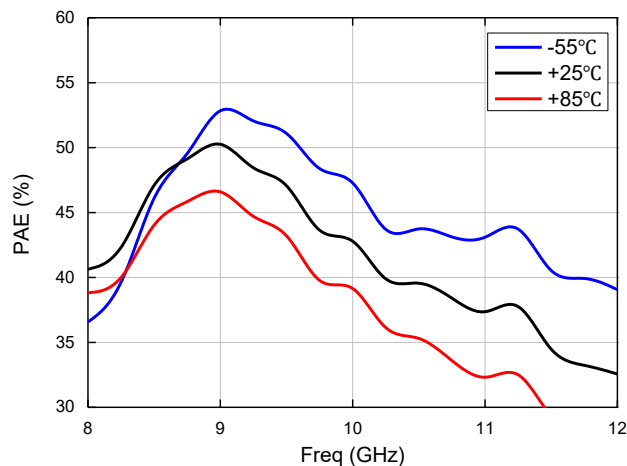
*在-3V~-2.4V范围内调节VG，使Pulse静态电流为1.85A，使CW静态电流为1.82A。

**VG参考值：-2.65V for Pulse，-2.82V for CW。

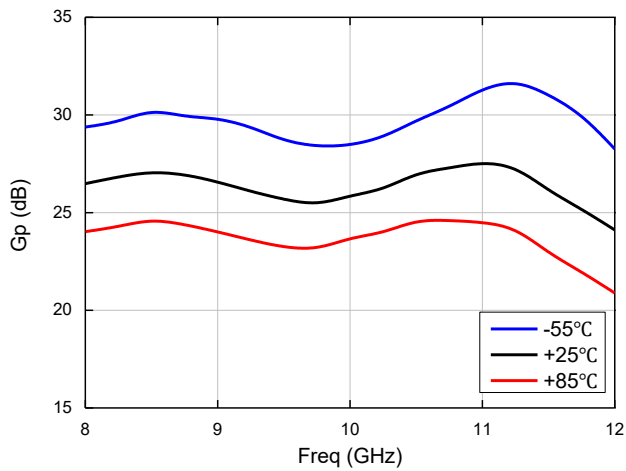
使用限制参数

最大漏极工作电压	+40V
最大栅极工作电压	-5V
最大输入功率	+30dBm
贮存温度	-65°C~+150°C
工作温度	-55°C~+85°C

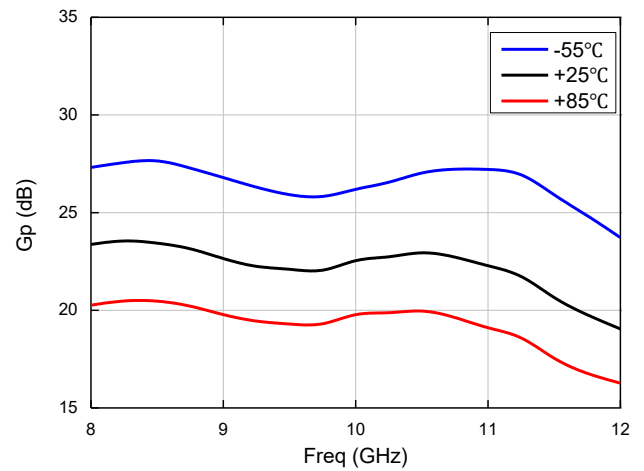
测试曲线 (VG=-2.65V for pulse, VG=-2.82V for CW, VD1=VD2=VD3=+28V, 脉冲测试条件:
100us/1ms)

小信号增益 (Pulse)

小信号增益 (CW)

饱和输出功率 (Pulse)

饱和输出功率 (CW)

功率附加效率 (Pulse)

功率附加效率 (CW)


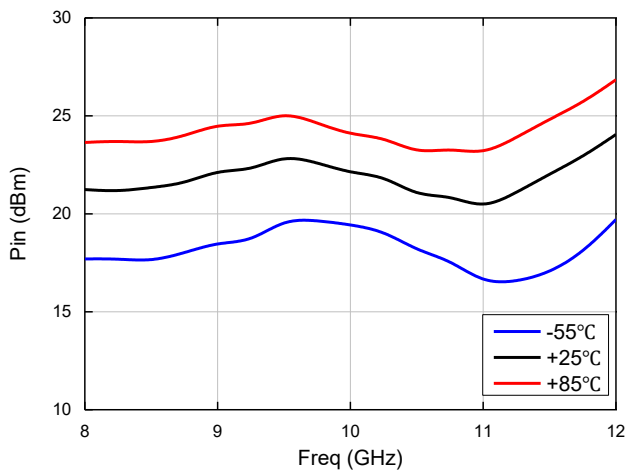
功率增益 (Pulse)



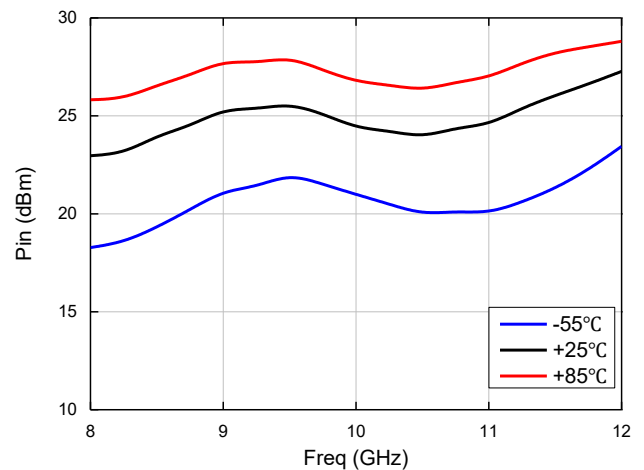
功率增益 (CW)



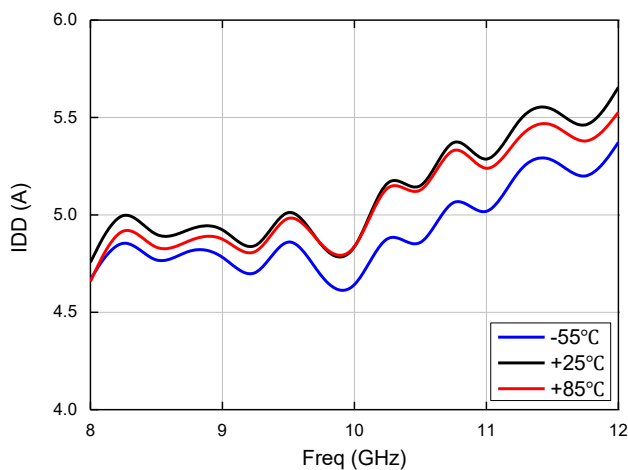
输入功率 (Pulse)



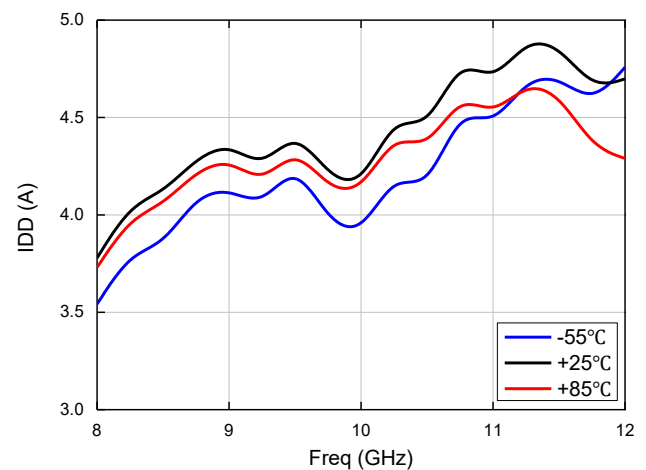
输入功率 (CW)



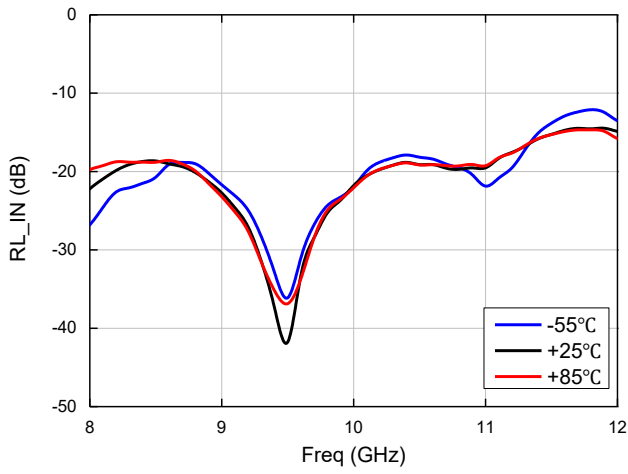
动态电流 (Pulse)



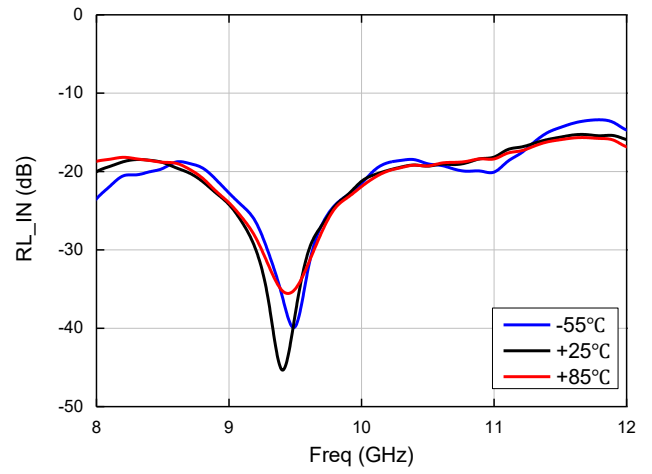
动态电流 (CW)



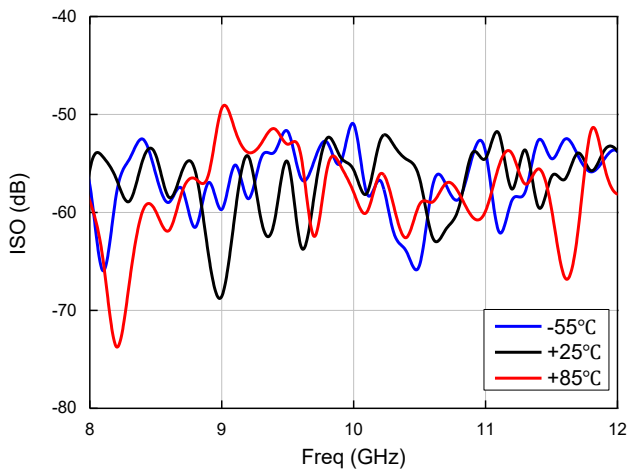
输入回波损耗 (Pulse)



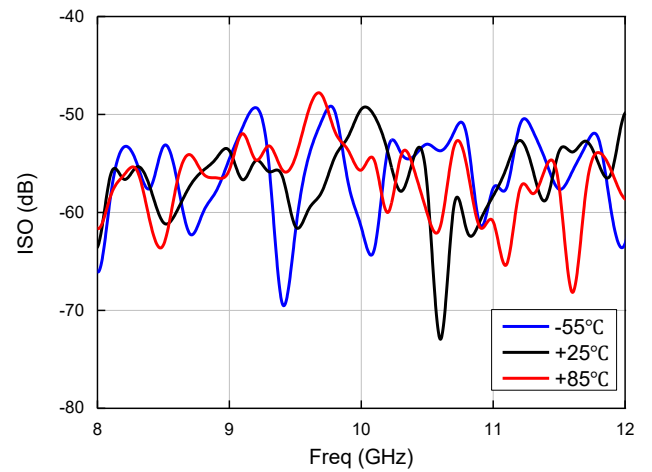
输入回波损耗 (CW)



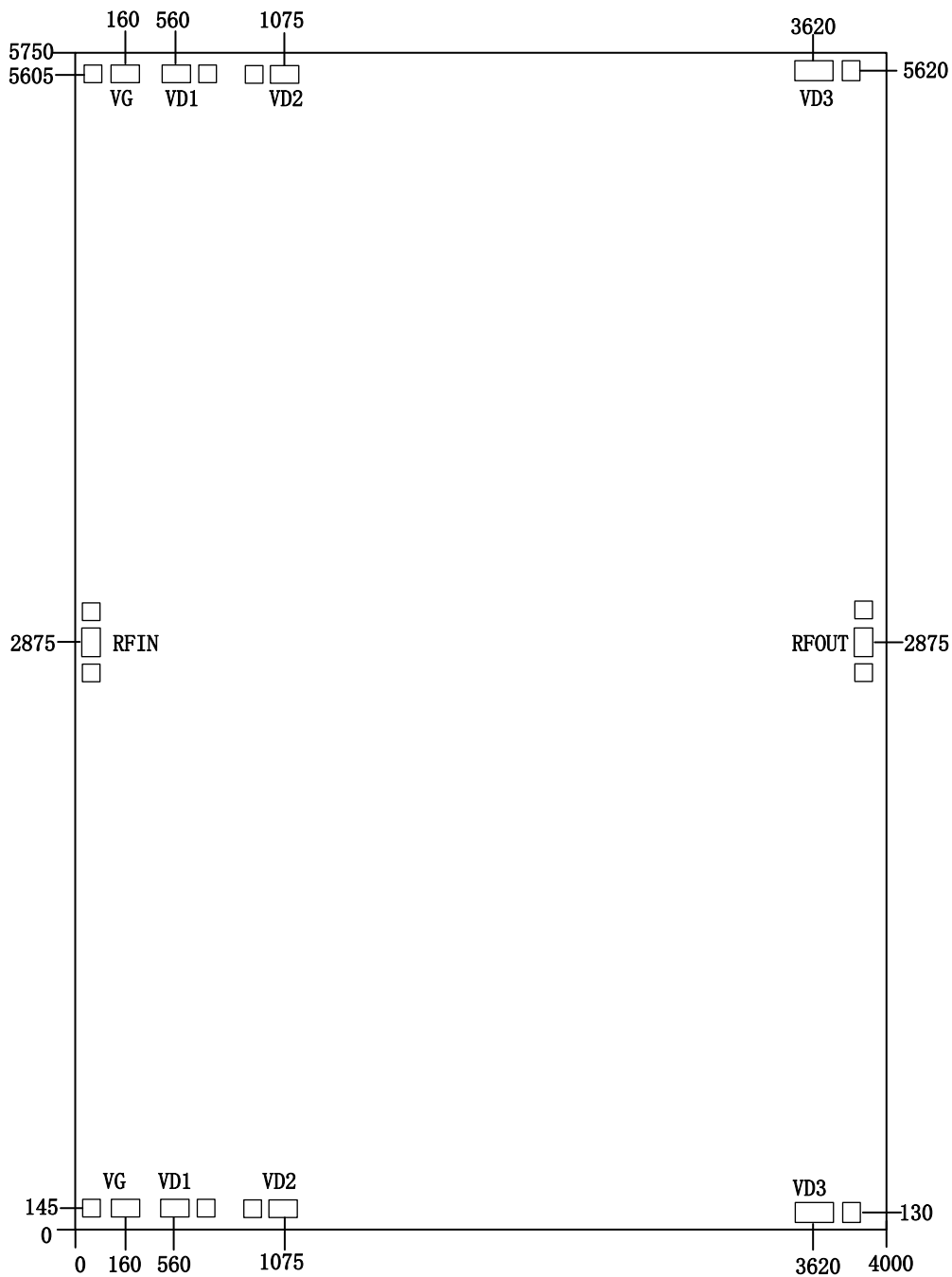
隔离度 (Pulse)



隔离度 (CW)

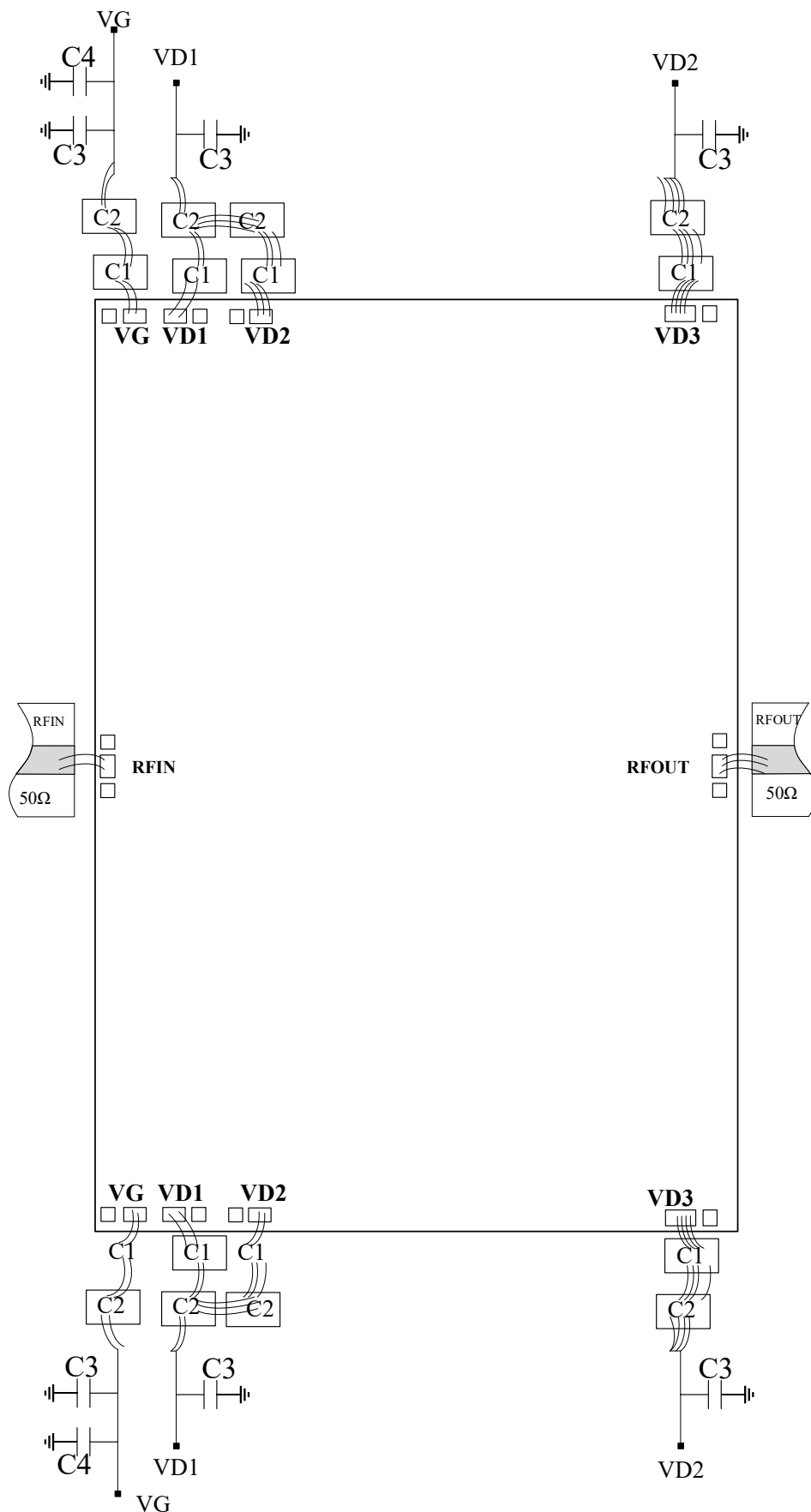


芯片端口图（单位：μm）



端口定义

端口名	定义	信号或电压
VG	电源负电，建议外加 100pF 电容	-2.65V(Pulse)/-2.82V(CW)
VD1/2/3	电源正电，建议外加 100pF 电容	+28V
RFIN	射频信号输入端	RF
RFOUT	射频信号输出端	RF
其他	接地	/

建议装配图


注：1、片外电容容值为C1=100pF，C2=1000pF，C3=0.1μF，C4=10μF，其中C1尽量靠近芯片。

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) SiC 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入用 2 根键合线，输出用 3 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线尽量短，不要长于 300 μ m；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。